

!

• • •

구분	소재	기술	생산량	비율	비고
Wacker-Chemie (Silicon Wafer)	Wacker Siltronic	Freiberg (Epitaxial)	4,3000		300mm
	Wacker	Wacker			300mm
	Wacker-Chemie				300mm
	Wacker Siltronic				
Wacker Siltronic	Wacker Siltronic	300mm			Shin-Etsu Handotai Sumitomo Mitsubishi Silicon 3
	Burghausen		4	20%	Wacker Hikari
	300mm	1			
	Freiberg	2004	8	가	6, 15
Wacker	Burghausen	2002	5		2003 7 5000
	가				
	Wacker	2002			2003
			가		
300mm (Piolt)	가				15 (Fab)
	Burghausen	가	100%	가	Shin-Etsu Shirakawa 7 가
	100%		Shin-Etsu	Shirakawa	10
Wacker	가	Freiberg			가
	Burghausen	300mm			가
	Freiberg	150mm		2000	(Monocrystal) 가 가
	Siltronic	200mm			
Wacker	Freiberg	300mm			
			6		Hall
	Wacker	300mm		5	
	14%				
Wacker		가			300mm 30%
	300mm		15%		가 가
	300mm	2005-06	30%,	30%,	20%,
	10%				
Polished		CVD (Chemical Vapor Deposition)			가
	25-30%				
	Wacker	Burghausen	3		Reactor 가 300mm 50%

Freiberg	300mm	60-65%	Furnacetreated	Annealed
200mm	100	가	, 300mm	가
300mm	200mm	2	200mm	300-400
가 300mm		30%		
300mm		가	가	200mm
				가

< 2003/8/25>